



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 36358—2018

## 半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范

Semiconductor optoelectronic devices—  
Blank detail specification for power light-emitting diodes

2018-06-07 发布

2019-01-01 实施

国家市场监督管理总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
**半 导 体 光 电 子 器 件**  
**功 率 发 光 二 极 管 空 白 详 细 规 范**

GB/T 36358—2018

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.spc.org.cn

服务热线:400-168-0010

2018年6月第一版

\*

书号:155066·1-60057

版权专有 侵权必究

## 前　　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部(电子)归口。

本标准起草单位:中国电子技术标准化研究院、中国电子科技集团公司第十三研究所、国家半导体器件质量监督检验中心、厦门市三安光电科技有限公司。

本标准主要起草人:赵英、刘秀娟、黄杰、彭浩、赵敏、邵小娟。

# 半导体光电子器件 功率发光二极管空白详细规范

## 引言

本空白详细规范是半导体光电子器件的一系列空白详细规范之一。

相关文件：

GB/T 2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.3—2016 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.4—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热(12 h + 12 h 循环)

GB/T 2423.5—1995 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦)

GB/T 2423.15—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ga和导则：稳态加速度

GB/T 2423.22—2012 环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化

GB/T 2423.23—2013 环境试验 第2部分：试验方法 试验Q：密封

GB/T 2423.28—2005 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验T：锡焊

GB/T 2423.60—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验U：引出端及整体安装件强度

GB/T 2424.19—2005 电工电子产品环境试验 模拟贮存影响的环境试验导则

GB/T 4589.1—2006 半导体器件 第10部分：分立器件和集成电路总规范

GB/T 12565—1990 半导体器件 光电子器件分规范

SJ/T 11394—2009 半导体发光二极管测试方法

IEC 60191-2-DB-2012 半导体器件的机械标准化 第2部分：尺寸规格(Mechanical standardization of semiconductor devices—Part 2:Dimensions)

IEC 60749-21;2011 半导体器件 机械和气候试验方法 第21部分：可焊性(Semiconductor devices—Mechanical and climatic tests methods—Part 21:Solderability)

## 要求资料

下列所要求的各项内容，应列入规定的相应空栏中。

详细规范的识别：

[1] 授权发布详细规范的国家标准化机构名称。

[2] IECQ 详细规范号。

[3] 总规范和分规范的版本号和标准号。

[4] 详细规范的国家编号、发布日期及国家标准体系要求的任何更详细的资料。

器件的识别：

[5] 主要功能和型号。

[6] 典型结构(材料、主要工艺)和封装的资料。如果一种器件有几种派生的产品，那些不同点应被指出，例如在对照表中列出特性差异。